

Содержание

• Электронные и оптические свойства полупроводников

Певцов А.Б., Грудинкин С.А., Поддубный А.Н., Каплан С.Ф., Курдюков Д.А., Голубев В.Г.
Переключение фотонной запрещенной зоны в трехмерных пленочных фотонных кристаллах на основе композитов опал-VO₂ в спектральной области 1.3–1.6 мкм 1585

Артакин А.И., Добровольский А.А., Винокуров А.А., Зломанов В.П., Гаврилкин С.Ю., Иваненко О.М., Мицен К.В., Рябова Л.И., Хохлов Д.Р.
Особенности примесных состояний ванадия в теллуриде свинца 1591

Кульбачинский В.А., Кытин В.Г., Лаврухина З.В., Кузнецов А.Н., Шевельков А.В.
Гальваномагнитные, термоэлектрические свойства и электронное строение монокристаллических BiTeVg и BiTeI 1596

• Полупроводниковые структуры, границы раздела и поверхность

Анисимова Н.П., Тропина Н.Э., Тропин А.Н.
Увеличение эффективности вывода излучения тонкопленочных фотолюминесцентных композитных структур на основе PbSe 1602

Беляев А.Е., Болтовец Н.С., Бобыль А.В., Иванов В.Н., Капитанчук Л.М., Кладько В.П., Конакова Р.В., Кудрик Я.Я., Корчевой А.А., Литвин О.С., Миленин В.В., Новицкий С.В., Шеремет В.Н.
Радиационные эффекты и межфазные взаимодействия в омических и барьерных контактах к фосфиду индия, стимулированные быстрыми термическими обработками и облучением γ -квантами ⁶⁰Co 1607

Сизов В.С., Неплох В.В., Цацульников А.Ф., Сахаров А.В., Лундин В.В., Заварин Е.Е., Николаев А.Е., Минтаиров А.М., Merz J.L.
Исследование туннельного транспорта носителей в структурах с активной областью InGaN/GaN 1615

• Аморфные, стеклообразные, пористые, органические, микрокристаллические полупроводники, полупроводниковые композиты

Курова И.А., Ормонт Н.Н.
Особенности фотоэлектрических свойств слоистых пленок аморфного гидрированного кремния 1624

Светличный В.М., Александрова Е.Л., Мягкова Л.А., Матюшина Н.В., Некрасова Т.Н., Тамеев А.Р., Степаненко С.Н., Ванников А.В., Кудрявцев В.В.
Фотофизические свойства индоло[3,2-b]карбазолов — перспективного класса материалов для оптоэлектроники 1629

Горячев Д.Н., Беляков Л.В., Сресели О.М.
Свободные люминесцирующие слои пористого кремния 1636

• Физика полупроводниковых приборов

Винокуров Д.А., Николаев Д.Н., Пихтин Н.А., Станкевич А.Л., Шамахов В.В., Растегаева М.Г., Рожков А.В., Тарасов И.С.
InGaAs/GaAs/AlGaAs-лазеры, излучающие на длине волны 1190 нм, выращенные методом МОС-гидридной эпитаксии на подложке GaAs 1640

Кузнецов В.П., Шмагин В.Б., Марычев М.О., Кудрявцев К.Е., Кузнецов М.В., Андреев Б.А., Карнаухов А.В., Горшков О.Н., Красильник З.Ф.
Электролюминесценция на длине волны 1.5 мкм в диодных структурах Si:Er/Si, легированных акцепторами Al, Ga, B 1645

Емельянов В.М., Калюжный Н.А., Минтаиров С.А., Шварц М.З., Лантратов В.М.
Многопереходные солнечные элементы с брегговскими отражателями на основе структур GaInP/GaInAs/Ge 1649

• Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур

Атабаев И.Г., Хажиев М.У., Матчанов Н.А., Салиев Т.М., Бобожонов К.А.
Влияние поверхностных химических обработок на свойства контактов Ti-p-Si_{1-x}Ge_x и Ni-p-Si_{1-x}Ge_x 1655

Корчагина Т.Т., Володин В.А., Chichkov V.N.
Формирование и кристаллизация нанокластеров кремния в пленках SiN_x:H с применением фемтосекундных импульсных отжигов 1660

Астрова Е.В., Федулова Г.В., Гущина Е.В.
Формирование полосок двумерного фотонного кристалла путем одновременного фотоэлектрохимического травления щелей и макропор в кремнии 1666

• Персоналии

Юрий Васильевич Шмарцев
(к 80-летию со дня рождения) 1673

Юрас Пожела
(к 85-летию со дня рождения) 1674

Именной указатель 1675

Предметный указатель 1714